

маршрутизации, что позволяет изначальному узлу выбирать оптимальный путь при передаче информации и его задержку. Еще одним достоинством этого алгоритма является простота его реализации. Вместе с этим, дистанционно-векторный алгоритм имеет ряд недостатков: плохую сходимость – т.е. при использовании алгоритма возникает проблема при отключении одного из узлов сети; сложность при расширении сети, что приводит к увеличению вероятности проблемы «Count to infinity» (счет до бесконечности).

Алгоритм маршрутизации по состоянию канала относится к адаптивным алгоритмам и основан на анализе состояния связей. Изначально в узле содержатся сведения о его соседях и метрике связей, соединяющих его с ними. В процессе обмена информацией с соседними узлами, узел получает информацию о топологии сети, при этом обменивается только информацией о произошедших изменениях. В результате каждый узел знает всю топологию сети.

Исследование алгоритма маршрутизации по состоянию канала позволило выделить некоторые его достоинства. В первую очередь это быстрая сходимость, т.е. алгоритм не склонен к образованию петель и счета до бесконечности. Как недостаток, следует отметить сложность расчета, что приводит к необходимости увеличения процессорной мощности и памяти.

Результаты проведенного анализа позволили определить направления исследования по созданию алгоритма маршрутизации, который бы как можно больше исключил недостатки и использовал преимущества вышеперечисленных алгоритмов маршрутизации.

При создании нового алгоритма использованы принципы построения кратчайших путей, которые применяются в алгоритмах Дейкстры и Беллмана-Форда, и методы определения средней задержки, традиционные для сетей с пакетной коммутацией. Предложенный алгоритм основан на минимизации средней задержки на всех кратчайших маршрутах, причем определение задержек на участках включает анализ статических характеристик сети (топологии и пропускных способностей каналов связи) и характера передаваемого трафика (учет оптимальных показателей задержек для разных видов трафика).

В алгоритме предусмотрены механизм анализа пропускной способности каналов связи с точки зрения их оптимальности, порядок расчета оптимального веса путей, на основании минимизации функции задержки в сети и анализа потока по маршрутам, при котором размер задержки мог бы соответствовать общепринятым характеристикам передачи определенных видов трафика. Использование данного алгоритма в системах дистанционного управления электронными аппаратами позволит увеличить скорость передачи информации, обеспечить быструю сходимость по оптимальным маршрутам.

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ВИХРЕТОКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ

Светличный В.А.

Научный руководитель – проф. к.т.н. Хорошайло Ю.Е.

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

The basic mathematical conditions for the construction of eddy current flaw detectors. The classification of primary information converters. Displaying prospects for eddy current nondestructive testing instruments.

Глубокое исследование вихреточного метода возможно выполнить только с помощью его математической модели. Физической основой для работы вихреточных дефектоскопов и толщиномеров являются уравнения Максвелла для электромагнитного поля (ЭМП).

$$\operatorname{rot} \vec{E} = - \frac{d\vec{B}}{dt} \text{ и } \operatorname{rot} \vec{H} = j_{\text{ни}} \quad (1)$$

где \vec{B} – вектор напряженности магнитного поля, \vec{H} – вектор магнитной индукции, $j_{\text{ни}} = J_{\text{ш}} + J_{\text{н}} + J_{\text{шо}} + J_{\text{нио}}$, где $J_{\text{ш}}$, $J_{\text{н}}$, $J_{\text{шо}}$, $J_{\text{нио}}$ – соответственно плотности тока: проводимости, смещения, переноса, сторонних токов.

Рассмотрим математическую модель взаимодействия внешнего ЭМП с ЭМП вихревых токов, наводимых в электропроводящем объекте контроля. Пусть вектор напряженности магнитного поля H изменяется во времени по синусоидальному закону с круговой частотой ω , тогда для проводящей ($J_{\text{нио}} \approx 0$), неподвижной ($J_{\text{нио}} \approx 0$) и изотропной ферромагнитной среды, выражение (1) как известно, определяется уравнением Гельмгольца;

$$\nabla^2 H + k^2 H = 0, \quad (2)$$

где $k^2 = -j\omega\mu_0\sigma$, μ_0 – абсолютная магнитная проницаемость $= \mu_0\mu_r$,

μ_0 – магнитная постоянная, $\mu_r = \frac{dB}{dH}$ – дифференциальная магнитная проницаемость, σ – удельная электрическая проводимость.

Уравнения Максвелла (при условии неподвижности и изотропности среды), возможно свести к уравнению векторного магнитного потенциала A определяемого выражением:

$$B = \operatorname{rot} A, \quad (3)$$

$$\nabla^2 A - \mu_0\sigma \frac{dA}{dt} = -\mu_0 J_{\text{ни}}, \quad (4)$$

при монохромном возбуждении ЭМП получим $\nabla^2 A + k^2 A = -\mu_0 j_{\text{ни}}$,
(5)

Если объект контроля неферомагнитный тогда нужно учесть $J_{\text{ни}} \neq 0$. При условии $\sigma \approx \omega\epsilon_a$, где $\epsilon_a = \epsilon_0\epsilon_r$ – абсолютная диэлектрическая проницаемость, ϵ_0 – диэлектрическая постоянная. В этом случае, при векторе скорости переноса $V = 0$ и монохроматическом возбуждении ЭМП в линейной изотропной среде уравнения Максвелла приобретают вид:

$$\operatorname{rot} \vec{H} = (\sigma + j\omega\epsilon_0)\vec{E} + \vec{j}_{\text{снор}}; \quad \operatorname{rot} \vec{E} = -j\omega\mu_0\vec{H} \quad (6)$$

$$\text{После преобразования получим } \nabla^2 \vec{A} + k_e^2 \vec{A} = -\mu_0 \vec{j}_{\text{снор}} \quad (7)$$

$$\text{или } \nabla^2 \vec{H} + k_e^2 \vec{H} = -\operatorname{rot} \vec{j}_{\text{снор}}, \text{ где } k_e^2 = \mu_0(\omega^2 \epsilon_0 - j\omega\sigma). \quad (8)$$

При условии $\sigma > \omega\epsilon_0$, $k_e = k_e$ и (7) возможно преобразовать в (5), а (8) - в (2) с правой частью в виде $-\operatorname{rot} \vec{j}_{\text{снор}}$. Как известно, векторный потенциал \vec{A} в монохроматическом ЭМП с напряженностью электрического поля \vec{E} соотношением

$$\vec{E} = -j\omega \vec{A}. \quad (9)$$

Мгновенное значение электродвижущей силы (э.д.с.) измерительной обмотки вихревокового преобразователя дефектоскопа с числом витков w_i может быть выражено:

$$e(t) = -w_i \frac{d\Phi}{dt} \quad (10)$$

где Φ - сцепленный магнитный поток, этой катушки.

Для линейной среды и осесимметричного монохроматического поля комплексная э.д.с катушки равна:

$$\hat{E} = -j\omega w_i \hat{\Phi}; \quad (11)$$

$$\hat{E} = -j\omega w_i i \vec{A}, \quad (12)$$

где i - длина контура измерительной обмотки, сосновой с возбуждающей обмоткой преобразователя дефектоскопа.

Границные условия для тангенциальных составляющих H и нормальными составляющими B на границе раздела сред 1 и 2 имеют вид:

$$E_{1t} = E_{2t}; \quad (13)$$

$$H_{1n} = H_{2n}; \quad (14)$$

$$B_{1n} = B_{2n}; \quad (15)$$

Из (13) и (9), а также из (14) и (12) следует:

$$A_{1t} = A_{2t}; \quad (16)$$

$$\frac{1}{\mu_1} (\operatorname{rot} \vec{A})_{1t} = \frac{1}{\mu_2} (\operatorname{rot} \vec{A})_{2t}. \quad (17)$$

Для практических (инженерных) расчетов удобно использовать комплексную э.д.с катушки \hat{E} , а относительную э.д.с. $\hat{U}_r = \frac{\hat{E}}{\hat{Y}_0}$, где \hat{Y}_0 модуль начальной э.д.с, соответствующий отсутствию объекта в зоне контроля. Соответственно: относительное напряжение $\hat{U}_r = \frac{\hat{U}}{\hat{U}_0}$, относительный магнитный поток $\hat{\Phi}_r = \frac{\hat{\Phi}}{\hat{\Phi}_0}$, относительный векторный потенциал $\lambda_r = \frac{\lambda}{\lambda_0}$.

$$\hat{U}_r = -\hat{\mathcal{E}}_r = j\hat{\Phi}_r = j\hat{A}_r. \quad (18)$$

Комплексное сопротивление однообмоточного (параметрического) преобразователя дефектоскопа определяется соотношением.

РАЗРАБОТКА, ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММАТОРА AVR МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ

Слободчук А. Ю., Днищенко А.А.

Научный руководитель - Воронов В. Ф.

Харьковский колледж государственного университета информационно-коммуникационных технологий

(61003, Харьков-3, ул. Кооперативная, 7, каф. Телекоммуникации)

E-mail: educate@duikt.kharkov.ua, факс (057) 731-30-63

Considered the types and areas of AVR microcontrollers, programmers and production phases of practical methods for their use of microcontroller specific functions. The proposed method worked and implementation of programming AVR microcontrollers.

Развитие микрэлектроники привело к широкому применению микропроцессорных устройств и изделий в промышленном производстве.

Микроконтроллеры представляют собой эффективное средство автоматизации разнообразных объектов и процессов. В частности на микроконтроллерах построены: АТС, концентраторы (хабы, свичи), маршрутизаторы и т. д.

Наиболее распространены микроконтроллеры следующих фирм производителей:

- Microchip - выпускающая PIC микроконтроллеры,

- Atmel - выпускающая AVR микроконтроллеры,

- Cognexant - выпускающая ARM микроконтроллеры.

Программирование микроконтроллеров обычно осуществляется на языке ассемблера или Си. Для отладки программ используются программные симуляторы (специальные программы для персональных компьютеров, имитирующие работу микроконтроллера), внутрисхемные эмуляторы и интерфейс JTAG.

Устройства для записи программ в микроконтроллер называются программаторами.

Существуют программаторы для программирования микроконтроллеров с использованием интерфейсов ПК:

-LPT,

-COM,

-USB.

В статье рассмотрены этапы проектирования и изготовления программатора.

Принципиальная схема и монтажная плата программатора на этапе проектирования и изготовления представлены на рисунке 1.

Эскиз печатной платы был выполнен с помощью программы Sprint Layout V.5 в соответствии с указанной принципиальной схемой

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

МАТЕРИАЛЫ 15-ГО ЮБИЛЕЙНОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В XXI веке»

18 – 20 апреля 2011 г.

Том 2

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ПРИБОРОСТРОЕНИЕ КАК ОСНОВА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА»

15-й Юбилейный Международный молодежный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». Сб. материалов форума. Т. 2. - Харьков: ХНУРЭ. 2011. – 324 с.

В сборник включены материалы 15-го Юбилейного Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке».

Подані підготовані факультетом електронних апаратов
Харківського національного університета радіоелектроніки (ХНУРЭ)

61166 Україна, Харків, просп. Леніна, 14
тел.: (057) 7021397
факс: (057) 7021515

E-mail: innov@kture.kharkov.ua

**СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСОБИ
АВТОМАТИЗАЦІЇ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ**

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
ХАРЬКОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

МАТЕРИАЛЫ 15-го ЮБИЛЕЙНОГО
МЕЖДУНАРОДНОГО
МОЛОДЕЖНОГО ФОРУМА

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В ХХІ веке»

18 – 20 апреля 2011 г.

Том 2

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**«РАДИОЭЛЕКТРОННОЕ ПРИЕМОСТРОЕНИЕ КАК ОСНОВА
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВА»**

АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК

О	Г	Н
Orji Evertus Zeluwa	Горлач Д.С.	Назаренко Р.В.
314	Грищенко С.В.	158, 174 40
С	Гудков С.А.	Небесник О.Ю.
Chukwuemeka Kalu Ole	Д	243
60	Деменюк О.Е.	Нестеренко Д.В.
А	Денисенко М.Е.	176
Андреасян Г.М.	Демин А.И.	Низяев Е.А.
63	Деревянко Ю.В.	40
Андреасян М.М.	Днищенко А.А.	О
Б	Донсков А.Н.	Обуховский Д.О.
Базилук О.І.	Донской А.А.	225 42
146	Драгунцев М.Е.	Орехов А.Д.
Базук М.О.	Дробот С.В.	178
148	Дьяченко Е.Л.	Орехова С.Д.
Беденко Д.А.	Е	П
241	Евдолов О.В.	Павлов А.Н.
Бедзір А.О.	Евсеев В.В.	274, 292 69
195	Егоров М.Н.	Навлусенко М.Н.
Белановский Г.И.	Елецкий А.А.	180
65, 239	Ж	Пахомов С.А.
Беликов А.О.	Жабина В.С.	182
67, 69	Жарикова И.В.	Перевозник А.А.
Беляев А.С.	З	Петренко Е.Б.
4	Забельский А.М.	113
Берестова Е.В.	Загорулько Г.В.	Печенежский С.В.
269	Зайка Д.Ю.	44
Богдан Ю.И.	Закревский А.Ф.	Пилипенко В.В.
71	Заморий П.Ю.	Повернов Е.С.
Бомбик В.С.	Заркуа Г.О.	294
197	Заярюк Н.М.	Полуянович М.С.
Бондар С.В.	Збираник В.П.	115
270	Зриби Иед	Пономарев В.Н.
Борисенко А.С.	Зубков Н.А.	180, 184
73	И	Пономарева А.В.
Бородай О.Я.	Иванов А.В.	247
150	Иващенко С.А.	Прохnenko Ю.И.
Бортникова В.О.	Ивченко В.В.	Р
152	Ивлев Д.В.	Розіскюзов С.С.
Босов І.А.	Ильченко О.М.	184
6	К	Рубленко В.А.
Грайтан С.С.	Кальницкий І.О.	225
199	Карнаух Р.А.	Рудийко Р.В.
Бурика С.В.	Карпенко В.Ю.	С
284	Кирьянук М.В.	Савчук Б.С.
Бысько Р.А.	Клімашевська В.М.	119
8	Ключник И.И.	Свєтличний В.А.
В	Кожин Г.А.	Сворінь В.М.
Верёвкин О.С.	К	186
160	Кальницький І.О.	Сворінь Н.М.
Веселая О.О.	Карнаух Р.А.	188
71	Карпенко В.Ю.	Селенкова Н.П.
Виноградов Н.И.	Кирьянук М.В.	46
75	Клімашевська В.М.	Сенников А.В.
Владов С.І.	Ключник И.И.	109
77	Кожин Г.А.	Сердаков Н.М.
Вовк Ю.С.	К	190
201	Н	Сердюк И.В.
Воруничев Д.С.	Настенко В.В.	115
272	Настенко В.В.	Сергійчук Ю.
Г	Н	251
Габитов И.А.	Н	Сидоренко А.И.
85	Н	296
Галкин П.В.	Н	Симурзин А.А.
73, 101	Н	231
Галюк В.А.	Н	Скорик И.В.
79	Н	48
Ганжа Ю.С.	Н	Скориков Ю.А.
6	Н	50
Гарячевская Л. В.	Н	Скрипник С.В.
261	Н	182
Геворгян К.А.	Н	Слепушко Н.Ю.
231	Н	253
Герасимов Д.В.	Н	Слободчук А.Ю.
274, 302	Н	121
Глебова Л.В.	Н	Смашний Д.В.
203	Н	255
Гнатко Д.В.	Н	Соклаков Д.А.
10	Н	123
Головатый А.В.	Н	Сотник С.В.
65	Н	52
Головко А. Н.	Н	Степенко С.А.
288	Н	125
Головко И.	Н	Стоян А.А.
251	Н	127
Гончар В.В.	Н	Ступа А.С.
12	Н	160
Горбушико К.Е.	Н	
154	Н	
	Кожин Г.А.	
	34	
		317

	Т
Тарадаха П.В.	146
Терентьев С.А.	298
Терновой В. А.	286
Тимохина Л.С.	131
Тищенко А.А.	257
Триполка А.В.	259
Тупикина Н.Ю.	300, 302
Тюра И.В.	257
	У
Удовиченко А.Г.	310
Усков С.С.	192
Ускова И.А.	304
Устименко А.И.	148
	Ф
Филищенко И.О.	306, 308
	Х
Хатюк И.С.	54, 56
	Ч
Чугунов В.В.	133, 135
Чучумашева В.С.	137
	Ш
Шваченко А.И.	310
Шевченко М. А.	261
Шинкаренко Ю.К.	139, 141
Шмакай С.Л.	40
Шмонин А.Ю.	143
Шулика С. В.	30, 36, 50
	Щ
Щербатий В.М.	263
	Ю
Юр Т.В.	265
	Я
Якушева О.Ю.	312
Яровенко Ю.Б.	58

СОДЕРЖАНИЕ

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАСОБИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РАДІОЕЛЕКТРОННОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ.....	3
РЭА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ.....	62
СИСТЕМНЫЕ СРЕДСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ПРОИЗВОДСТВА И ЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ.....	145
НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ РЭА И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.....	194
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ.....	267
АЛФАВИТНЫЙ СПИСОК.....	316
СОДЕРЖАНИЕ.....	319

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА И МОЛОДЕЖЬ В XXI веке»

материалы 15-го Юбилейного Международного молодежного форума

Ответственные за выпуск:

Н.И. Слипченко
А.И. Филиппенко
Е.С. Булавина

Материалы сборника публикуются в авторском варианте
без редактирования

Підп. до друку 21.03.11. Формат 60x841/16. Спосіб друку – ризографія.

Умов. друк. арк. 18,4. Облік. вид. арк. 16,8. Тираж 173 прим.

Зам. № 2-256. Ціна договірна.

ХНУРЕ. Україна. 61166, Харків, просп. Леніна, 14

Віддруковано в навчально-науковому
видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ
Харків, просп. Леніна, 14